

**Сведения об официальном оппоненте**  
 по диссертационной работе Андреевой Александры Юрьевны «Исследование  
 косвенных обменных взаимодействий в многоядерных комплексах  
 лантаноидов (Ln(III) = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb)»  
 представленной на соискание ученой степени  
 кандидата физико-математических наук  
 по специальности 02.00.04 – физическая химия

Фамилия Имя Отчество оппонента	Терещенко Олег Евгеньевич
Шифр и наименование специальностей, по которым защищена диссертация	01.04.10- физика полупроводников
Ученая степень и отрасль науки	Д.ф.-м.н., 2014
Ученое звание	Профессор РАН
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук
Занимаемая должность	Старший научный сотрудник, и.о. зав. лаборатории физики и технологии гетероструктур
Почтовый индекс, адрес	630090 Новосибирск, проспект ак. Лаврентьева 13
Телефон	(383) 3307445
Адрес электронной почты	teresh@isp.nsc.ru
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 10 публикаций)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. M. S. Aksenov, A. Yu. Kokhanovskii, P. A. Polovodov, S. F. Devyatova, V. A. Golyashov, A. S. Kozhukhov, I. P. Prosvirin, S. E. Khandarkhaeva, A. K. Gutakovskii, N. A. Valisheva, and O. E. Tereshchenko, InAs-based metal-oxide-semiconductor structure formation in low-energy Townsend discharge. Appl. Phys. Lett. 107 (2015) 173501.</li> <li>2. T. Bathon, S. Achilli, P. Sessi, V.A. Golyashov, K. A. Kokh, O. E. Tereshchenko, and M. Bode, Experimental Realization of a Topological p–n Junction by Intrinsic Defect Grading. Advanced Materials 28, issue 11, 2183–2188 (2016) doi:10.1002/adma.201504771</li> <li>3. L.Viti, D. Coquillat, A. Politano, K. Kokh, Z. Aliev, M. Babanly, O.E. Tereshchenko, W.Knap, E.Chulkov, and M.Vitiello, Plasma-wave Terahertz detection mediated by topological insulators surface states. Nano Lett. 16(1), 80-87 (2016)</li> <li>4. H. Maass, H. Bentmann, C. Seibel, C. Tusche, S.V. Eremeev, T.R.F. Peixoto, O.E. Tereshchenko, K.A. Kokh, E.V. Chulkov, J. Kirschner, and F. Reinert, Spin-texture inversion in the giant-Rashba semiconductor BiTeI. Nature Communications 7,</li> </ol>

